

Приложение 1

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Каргин Николай Иванович
2	Дата рождения (полная)	19 ноября 1954
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор технических наук (специальность 05.27.06)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 https://mephi.ru info@mephi.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Высшее учебное заведение
	Наименование подразделения	Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике
	Должность	Директор Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Safonov D.A., Vinichenko A.N., Kargin N.I., Vasil'evskii I.S. Electron transport in PHEMT AlGaAs/InGaAs/GaAs quantum wells at different temperatures: influence of one-side δ-Si doping. Semiconductors, 52 (2) с.189-194 (2018) 2. Vinichenko A.N., Safonov D.A., Kargin N.I., Vasil'evskii I.S. Electron-quantum transport in pseudomorphic and metamorphic $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$-based quantum wells. Semiconductors, 53 (3) с.339-344 (2019) 3. Волков Николай Викторович, Каргин Николай Иванович, Тимошенков Андрей Степанович Особенности применения f1b-технологии для изготовления нанозаэлементов МЭМС. Наноиндустрия, s89 с.535-538 (2019) 4. Сафонов Д.А., Виниченко А.Н., Каргин Н.И., Васильевский И.С. Эффективная масса и время релаксации импульса электронов в односторонне delta-легированных PHEMT квантовых ямах AlGaAs/InGaAs/GaAs с высокой электронной плотностью. Письма в журнал технической физики, 44 (24) с.120-127 (2018) 5. Сафонов Д.А., Виниченко А.Н., Каргин Н.И., Васильевский И.С. Особенности ионизации доноров кремния и рассеяние электронов в псевдоморфных квантовых ямах AlGaAs/InGaAs/GaAs при сильном одностороннем delta-легировании. Письма в журнал технической физики, 44 (4) с.34-41 (2018) 	

	<p>6. Гришаков К.С., Елесин В.Ф., Каргин Н.И., Рыжук Р.В., Миннебаев С.В. Влияние алмазного теплового распределителя на характеристики транзисторов на основе нитридов галлия. Микроэлектроника, 45 (1) с.44-56 (2016)</p> <p>7. Bolshakova I., Kost Y., Radishevskiy M., Shurygin F., Vasylyev A., Bulavin M., Kulikov S., Kargin N., Strikhanov M., Vasil'evskii I., Kuech T. Metal hall sensors for the new generation fusion reactors of demo scale. Nuclear fusion, 57 (11) с.116042 (2017)</p> <p>8. Буробин В.А., Каргин Н.И., Коновалов А.М., Макаров А.А., Щука А.А. Особенности разработки процесса выращивания структур InAlN/GaN методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений, применяемых в свч-транзисторах с высокой удельной выходной мощностью. Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век, 7 (1) с.22-26 (2015)</p> <p>9. Буробин В.А., Волошин А.Ю., Каргин Н.И., Макаров А.А., Щука А.А. Особенности эпитаксиального выращивания гетероструктур для твердотельного освещения. Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век, 7 (1) с.27-30 (2015)</p> <p>10. Шостаченко Станислав Алексеевич, Захарченко Роман Викторович, Миннебаев Станислав Вадимович, Рыжук Роман Валериевич, Маслов Михаил Михайлович, Катин Константин Петрович, Каргин Николай Иванович, Ковальчук Николай Георгиевич, Комиссаров иван Владимирович, Лабунов В.А. Влияние подзатворного диэлектрика на вольт-амперные характеристики транзистора с каналом на основе графеносодержащей пленки. Известия ЮФУ. Технические науки, 9 (170) с.94-101 (2015)</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты